

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

СЕКЦИЯ «ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ И НАНОЭЛЕКТРОНИКА»

<i>Артемьев А.А., Галимов А.И., Миленцев А.С., Молдавская М.Д., Шалыгин В.А.</i> Равновесные спектры отражения и пропускания наноструктур GaN/AlGaN/Al ₂ O ₃ в терагерцовом диапазоне частот	
<i>Балахтарь Г.Р., Костянян А.А.</i> Переход донор-зона проводимости в квантовой яме GaAs	
<i>Галимов А.И., Орлов Е.Ю., Молдавская М.Д., Шалыгин В.А.</i> Латеральная электропроводность гетероперехода GaN/AlGaN в сильных электрических полях	
<i>Ганбарова Т.Ш., Бабичев А.В., Рыков С.А.</i> Сканирующая туннельная микроскопия графена на микроструктурированной подложке	
<i>Пашнев Д.А., Балагула Р.М., Софронов А.Н.</i> Распределение носителей заряда в квантовых точках Ge/Si с неоднородным уширением спектра поглощения	
<i>Рыбалко Д.А., Полухин И.С., Одноблюдов М.А., Соловьев Ю.В., Михайловский Г.А.</i> Численное моделирование параметров лазера с пассивной синхронизацией мод на структурах с пониженной размерностью для оптимизации дизайна	
<i>Сорокина А.А., Махов И.С., Винниченко М.Я.</i> Влияние оже-рекомбинации на концентрацию и разогрев носителей заряда в структурах с квантовыми ямами InGaAsSb/AlGaAsSb	
<i>Юрков К.К., Балагула Р.М., Винниченко М.Я.</i> Поглощение терагерцового излучения свободными электронами в эпитаксиальных слоях GaN в электрическом поле	
<i>Фетисова М.В., Гасумянц В.Э., Мартынова О.А.</i> Поведение коэффициента Нернста-Эттингсгаузена в манганитах различных систем	